		Форма	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
						Документация	7	
		A3				Схема электрическая	Я	
						структурная		
		A3				Схема электрическая	Я	
						функциональная		
		A2				Схема электрическая	Я	
						принципиальная		
						<u> Микросхемы</u>		
				1	DD4	К555СП1	1	
				2	DD8	К555ИД7	1	
				3	DD27, DD33	К155ЛИ1	3	
				4	DD1, DD2	К555ИЕ10	2	
				5	DD13, DD14	К555ИМ6	2	
				6	DD26, DD28, DD29, DD31,	К155ЛН1		
и дата					DD35		5	
Эп. и				7	DD3, DD9, DD10, DD15, DD16,	K555UP11		
Подп.					DD17, DD18, DD19, DD20, DD20			
íл.					DD25		11	
Инв. № дубл.				8	DD36, DD37	K555NE8	2	
′нв. ∧				9	DD5, DD6, DD7, DD11, DD12,	К555КП16		
Nº N					DD21, DD22, DD23, DD24		9	
				10	DD32	K155/I/I1	1	
Взам. инв.								
B3								
ma								
и да								
Подп. и дата						Ποπο μυδι	ac TT/	
			Лис		⊵ докум. Подпись Дата	Поле чуде		
подл.			зраб. овер		лыгин В.К. Нилюк С.С.		Лит Лисп 1	т Листов 2
Инв. № подл.		Н. контр.			LXEM	мы устройства —	МГТУ им. Н.Э. Баумана	
ZH		Утверд.				Спецификация		-635 Donward A4

Форма	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечани
				Кварцевые резонаторы		
		11	ZQ1	DT-38	1	
				<u>Конденсаторы</u>		
					<u> </u>	
		12	Ε1	K50-68-25B-10 ΜΚΦ	1	
		13	<i>C2-C14</i>	КМ5Б-H90-0,1 мкФ	13	
				Designativ		
				<u>Резисторы</u>		
		14	<i>R1</i>	M/IT 0,125 - 1 KDM	1	
			<i>R5</i>	M/IT 0,125 - 1,8 KOM	1	
		16	R2, R4	M/IT 0,125 - 0,22 KOM	2	
		17	R3	M/IT 0,125 - 0,56 KOM	1	
			713	7 W 6,123 6,36 NGW		
				Разьемы		
		18	XP1	SCT1001H-05PL100	1	
		19	XP2	SCT1001H-02PL100	1	
		20	XP3	CKK7353LNS-1.5-11B	1	
				Cuo 0		Лист
Изм	Лис	m N	<u>№ докум.</u> Подпись Дата	Схемы устройства		2

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.